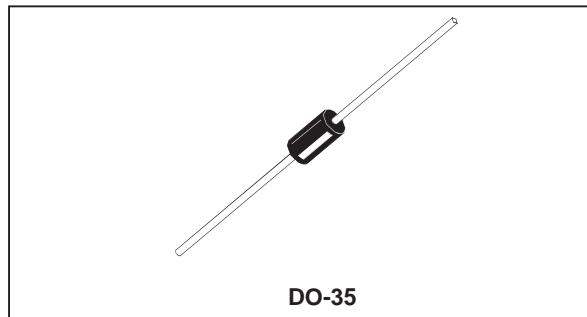


## SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE

### DESCRIPTION

Metal to silicon junction diode featuring high breakdown, low turn-on voltage and ultrafast switching. Primarily intended for high level UHF/VHF detection and pulse application with broad dynamic range. Matched batches are available on request



### ABSOLUTE RATINGS (limiting values)

Symbol	Parameter	Value	Unit
$V_{RRM}$	Repetitive Peak Reverse Voltage	70	V
$I_F$	Forward Continuous Current*	15	mA
$P_{tot}$	Power Dissipation*	430	mW
$T_{stg}$ $T_j$	Storage and Junction Temperature Range	- 65 to 200 - 65 to 200	°C
$T_L$	Maximum Lead Temperature for Soldering during 10s at 4mm from Case	230	°C

### THERMAL RESISTANCE

Symbol	Test Conditions	Value	Unit
$R_{th(j-a)}$	Junction-ambient*	400	°C/W

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

#### STATIC CHARACTERISTICS

Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{BR}$	$T_{amb} = 25^\circ C$ $I_R = 10\mu A$	70			V
$V_F$ **	$T_{amb} = 25^\circ C$ $I_F = 1mA$			0.41	V
	$T_{amb} = 25^\circ C$ $I_F = 15mA$			1	
$I_R$ **	$T_{amb} = 25^\circ C$ $V_R = 50V$			0.2	$\mu A$

#### DYNAMIC CHARACTERISTICS

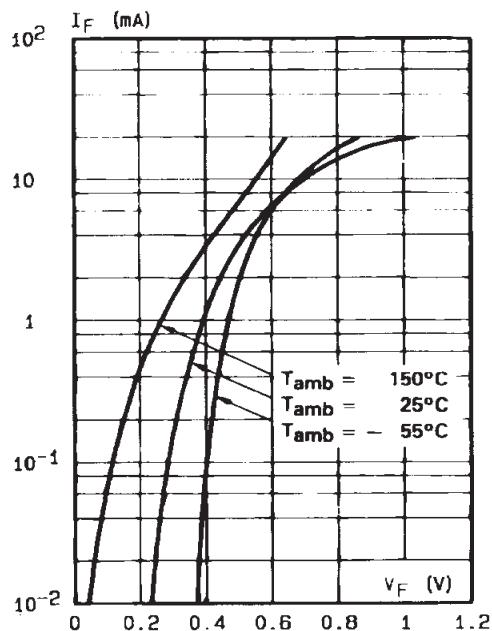
Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
C	$T_{amb} = 25^\circ C$ $V_R = 0V$ $f = 1MHz$			2	pF
$\tau$	$T_{amb} = 25^\circ C$ $I_F = 5mA$ Krakauer Method			100	ps

\* On infinite heatsink with 4mm lead length

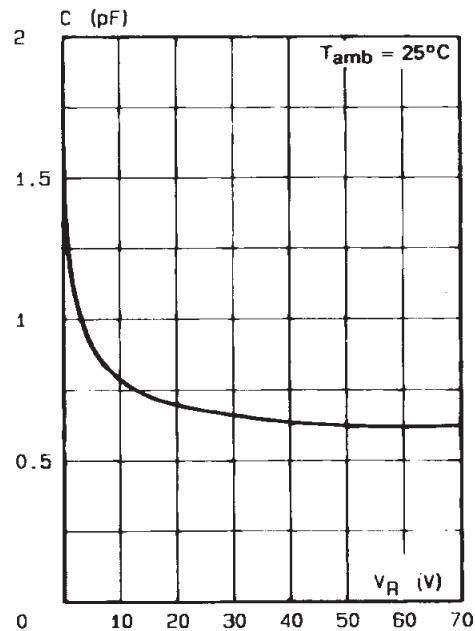
\*\* Pulse test:  $t_p \leq 300\mu s$   $\delta < 2\%$ .

Matched batches available on request. Test conditions (forward voltage and/or capacitance) according to customer specification.

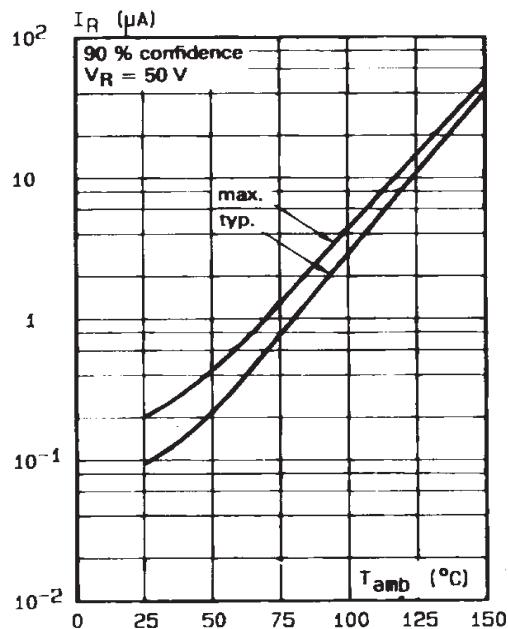
**Fig. 1:** Forward current versus forward voltage at low level (typical values).



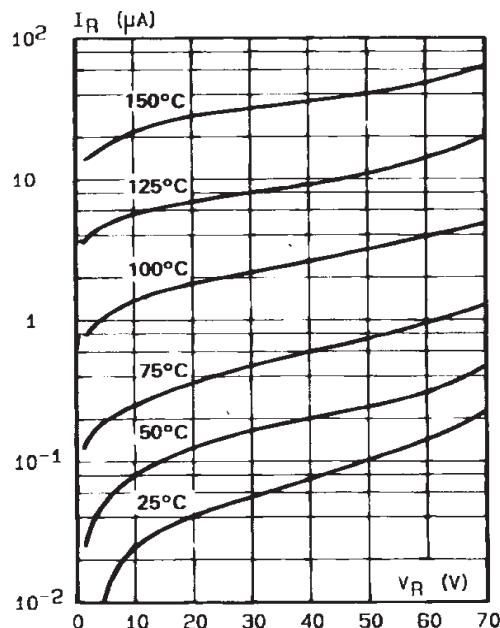
**Fig. 2:** Capacitance  $C$  versus reverse applied voltage  $V_R$  (typical values).



**Fig. 3:** Reverse current versus ambient temperature.



**Fig. 4:** Reverse current versus continuous reverse voltage (typical values).



**PACKAGE MECHANICAL DATA**  
DO-35

REF.	DIMENSIONS			
	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	3.05	4.50	0.120	0.177
B	1.53	2.00	0.060	0.079
C	28.00		1.102	
D	0.458	0.558	0.018	0.022

Cooling method : by convection and conduction

Marking: clear, ring at cathode end.

Weight: 0.15g

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied.

STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 2001 STMicroelectronics - Printed in Italy - All rights reserved.

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia  
Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>

**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9